

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เพชร (Diamond) เป็นวัสดุที่มีสมบัติพิเศษเฉพาะตัวที่โดดเด่น ทั้งทางด้านฟิสิกส์ เคมี และไฟฟ้า เช่น มีความแข็งที่สุด มีความต้านทานต่อกระแสไฟฟ้าสูง เจือยต่อปฏิกิริยาเคมี ฯลฯ ด้วยสมบัติดังกล่าวทำให้เพชรมีมูลค่าสูงในเชิงพาณิชย์ และเนื่องจากเพชรธรรมชาติมีข้อจำกัดในการใช้งานหลายอย่าง และมีอยู่อย่างจำกัด จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยและพยายามที่จะสังเคราะห์พัฒนาวัสดุชนิดใหม่ที่มีสมบัติเหมือนหรือใกล้เคียงเพชรให้มากที่สุด จนสามารถสังเคราะห์ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร (Diamond liked carbon, DLC) สมบัติโดยทั่วไปของฟิล์ม DLC ได้แก่ มีค่าความแข็งสูง ทนต่อรอยขีดข่วนและทนต่อการสึกกร่อนได้ดี จากสมบัติต่างๆ เหล่านี้ทำให้ฟิล์ม DLC สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้หลากหลายด้าน เช่นเป็น สิ่งประดิษฐ์ทางด้านไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ [1,2,3,4]

นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์ม DLC โดยการพัฒนาสมบัติสภาพนำไฟฟ้าของฟิล์ม DLC ด้วยการเจือ ซึ่งมี 2 แนวทาง คือการเจือด้วยโบรอนหรือ ไอโอดีน ลงบนฟิล์ม DLC เพื่อทำหน้าที่เป็นอะตอมตัวรับ ทำให้ฟิล์ม DLC มีคุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี และการเจือด้วยไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสเพื่อทำหน้าที่เป็นอะตอมตัวให้ ทำให้ฟิล์ม DLC มีคุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ในงานวิจัยส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านการทำฟิล์ม DLC เป็นชนิดพีซึ่งทำได้ง่ายและในปัจจุบันงานวิจัยที่ปรับปรุงลักษณะของฟิล์ม DLC เป็นชนิดพีค่อนข้างจะประสบความสำเร็จแล้ว ส่วนการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC มีลักษณะเป็นชนิดเอ็น เป็นการทำได้ยากมาก เพราะอะตอมตัวให้ส่วนใหญ่เป็นอะตอมที่มีขนาดใหญ่กว่าอะตอมของคาร์บอน ทำให้เกิดการทำลายโครงสร้างของฟิล์ม DLC ได้ อย่างไรก็ตามได้มีนักวิทยาศาสตร์สามารถสังเคราะห์ฟิล์ม DLC ชนิดเอ็นโดยไม่ทำลายโครงสร้างของฟิล์ม Dr. Koizumi และคณะพบว่าการใช้สารเจือฟอสฟอรัสในฟิล์ม DLC ให้ค่าแถบพลังงานกระตุ้น (activation energy) ในช่วง 0.49 - 0.60 eV ทำให้ค่าความต้านทานสูง เนื่องจากฟอสฟอรัสส่วนใหญ่แตกตัวทำให้มีปริมาณความเข้มข้นพาหะในชั้นแถบการนำ (conduction band) มีค่าน้อย เมื่อสังเคราะห์ฟิล์ม DLC เจือด้วยไนโตรเจนพบว่าค่าการนำไฟฟ้าของไนโตรเจนมีค่าอยู่ในช่วง $5.3 \times 10^{-13} - 1.14 \times 10^{-10} (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$ แถบพลังงานกระตุ้นเท่ากับ 1.7 eV และ I. Sakaguchi และคณะ สังเคราะห์ฟิล์ม DLC เจือด้วยซิลเฟอร์พบว่ามีการนำไฟฟ้าอยู่ในช่วง $10^8 - 10^{12} (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$ ค่าแถบพลังงานกระตุ้นของซิลเฟอร์มีค่า 0.380 eV การใช้พลังงานกระตุ้นน้อยแสดงว่าฟิล์มจะมีสภาพความต้านทานที่ต่ำและนำไฟฟ้าได้ดี

เหตุจูงใจในการใช้วิธีดีซีแมกนีตรอนสปีดเตอริงสำหรับการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC เนื่องจากเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ฟิล์มที่มีคุณภาพ มีการยึดเกาะกับวัสดุรองรับดี และสามารถสังเคราะห์ฟิล์ม DLC บนวัสดุรองรับได้หลายชนิด เช่น กระดาษโลหะ ซิลิคอน เซรามิกส์ อลูมิเนียม ฯลฯ [5] โดยกลไกในการสังเคราะห์อะตอมที่ผิวเป่าถูกทำให้หลุดออกมาพร้อมกับมีการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary electron) จากการระดมยิงของอนุภาคพลังงานสูงที่ถูกเร่งให้เคลื่อนที่เข้าชนเป้า และอนุภาคพลังงานสูงที่ใช้ในกระบวนการโดยทั่วไปจะใช้ไอออนของแก๊ส เพราะสามารถเร่งให้มีความเร็วสูงขึ้นได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการวิเคราะห์ฟิล์ม DLC เจือด้วยซัลเฟอร์ โดยวิธีดีซีแมกนีตรอนสปีดเตอริง

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึกษาผลของตัวแปร ได้แก่ อัตราส่วนปริมาณคาร์บอนต่อซัลเฟอร์ ความต่างศักย์ เวลาที่ใช้ในการสปีดเตอริง
2. ศึกษาสมบัติของฟิล์ม DLC จากข้อ 1 ที่โคปด้วยซัลเฟอร์ซึ่งสังเคราะห์โดยใช้เทคนิคดีซีแมกนีตรอนสปีดเตอริง

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1. ศึกษาผลของการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC ในสภาวะต่างๆดังนี้
 - อัตราส่วนของคาร์บอนต่อซัลเฟอร์ที่ใช้เป็นเป้า
 - ค่าความต่างศักย์
 - เวลาที่ใช้ในการสปีดเตอริง
2. ทดสอบคุณสมบัติของฟิล์ม DLC ที่สังเคราะห์ได้ โดยใช้
 - กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อดูลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม DLC
 - รามานสเปกโทรสโกปี เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างฟิล์ม DLC
 - วัดค่าสภาพนำไฟฟ้าของฟิล์ม DLC ที่สังเคราะห์ขึ้นโดยจ่ายศักย์ไฟฟ้าและวัดกระแสที่ไหลผ่านฟิล์ม
 - อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี (UV-VIS spectrophotometer)
 - สเปกโตรสโคปีอิลลิปโซเมทรี (Spectroscopic Ellipsometry)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.ทราบภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC ที่มีต่อลักษณะเฉพาะของรามานสเปกโทรสโกปีของฟิล์มซึ่งเชื่อมโยงสู่สมบัติของฟิล์มที่ดีขึ้น
- 2.เป็นต้นแบบในการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC โดยเจือด้วยซิลเฟออร์ โดยนำไปใช้ในงานด้านสารกึ่งตัวนำ และการใช้งานในลักษณะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

1.5 วิธีดำเนินการวิจัย

1. อัดเป้าคาร์บอนผสมกับซิลเฟออร์ในอัตราส่วนของซิลเฟออร์ตั้งแต่ 0-10% โดยโมล
2. สังเคราะห์ฟิล์ม DLC โดยมีตัวแปรที่ศึกษาดังนี้
 - อัตราส่วนของคาร์บอนต่อซิลเฟออร์ที่ 0-10% โดยโมล
 - ความต่างศักย์ที่ใช้ในการสเปคโตรริงในช่วง 400-500 V
 - เวลาที่ใช้ในการสเปคโตรริง 30-75 นาที
3. ทดสอบคุณสมบัติของฟิล์ม DLC โดยใช้
 - กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อศึกษาลักษณะของพื้นผิวฟิล์ม DLC และความหนาจาก cross section
 - รามานสเปกโทรสโกปีเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของฟิล์ม DLC
 - วัดค่าสภาพนำไฟฟ้าของฟิล์ม DLC ที่สังเคราะห์ขึ้นโดยจ่ายศักย์ไฟฟ้าและวัดกระแสที่ไหลผ่านฟิล์ม
 - ยูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เพื่อใช้ในการคำนวณหาพลังงานกระตุ้น (optical band gap)
 - สเปกโตรสโคปีกลิตลิปโซเมตรีเพื่อใช้ในการคำนวณหาพลังงานกระตุ้น (energy band gap) และความหนาของฟิล์ม
4. อภิปราย สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ

1.6 ลำดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย 5 บท รายละเอียดในแต่ละบทดังนี้

บทที่ 1 กล่าวถึงที่มาของปัญหาและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัยและลำดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย

บทที่ 2 กล่าวถึงความรู้พื้นฐานของ DLC รูปแบบของคาร์บอนในโครงผลึก โครงสร้างของฟิล์ม DLC กระบวนการสเปคโตรริงของฟิล์ม DLC การเจือด้วยสารในฟิล์ม DLC เทคนิคการ

สังเคราะห์ฟิล์ม DLC งานวิจัยในการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC โดยเจือด้วยโบรอน ไอโอดีน ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ในฟิล์มเพชร นอกจากนี้ยังประกอบด้วยทฤษฎีเบื้องต้นของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด การวิเคราะห์ทางรามาน ทฤษฎีอุยวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ สเปกโตรสโคปิกอิลลิปโซเมทรี และการวัดค่าสภาพนำไฟฟ้าของฟิล์ม DLC โดยเทคนิค two probe

บทที่ 3 กล่าวถึงขั้นตอนการทดลองซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการอัดเป่าที่ใช้ในระบบ และส่วนที่ 2 เป็นการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC โดยเทคนิคดีซีแมกนีตรอนสปีดเตอริง ตรวจสอบสมบัติของฟิล์มด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด รามานสเปกโทรสโกปี และ วัดค่าสภาพนำไฟฟ้าของฟิล์ม DLC ที่สังเคราะห์ขึ้นโดยจ่ายศักย์ไฟฟ้าและวัดกระแสที่ไหลผ่านฟิล์ม และคำนวณค่าแถบพลังงานของฟิล์ม DLC โดยอุยวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และสเปกโตรสโคปิกอิลลิปโซเมทรี

บทที่ 4 กล่าวถึงผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองโดยแบ่งออกเป็นสมบัติทางด้านสภาพนำไฟฟ้า สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางโครงสร้าง และสมบัติทางแสง

บทที่ 5 จะเป็นการสรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ